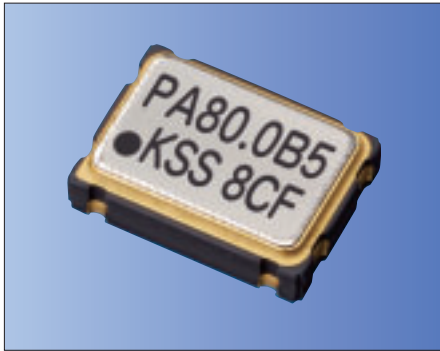


表面実装型クロック用水晶発振器 KC7050Bシリーズ (FXO-37FNBシリーズ)

CMOS/ 5.0V/ 7.0×5.0mm



RoHS対応品

■特長

- セラミックパッケージ・メタライズドリードの小型・薄型で自動搭載可能な表面実装用です。
- リフローはんだ付けが可能です。
- CMOS、TTL ICの直接駆動が可能なトライステート機能付のCMOS IC内蔵の水晶発振器です。
- 80MHz (PLL回路内蔵)
- 電源電圧 $V_{cc} = 5.0V$

■周波数許容偏差 (Overall)

許容偏差 コード × 10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備考
Z ±50	-10 ~ +85	80MHz

■品名表示方法

KC7050B 80.0000 C 5 Z B QZ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②出力周波数
- ③出力形態 (CMOS)
- ④電源電圧 5 = 5.0V
- ⑤周波数許容偏差 (左表参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能 (40/ 60%、スタンバイ)
- ⑦個別仕様 (カタログ仕様は「QZ」になります)

CC-Linkリモートデバイス局用通信LSI
MFP3N指定部品

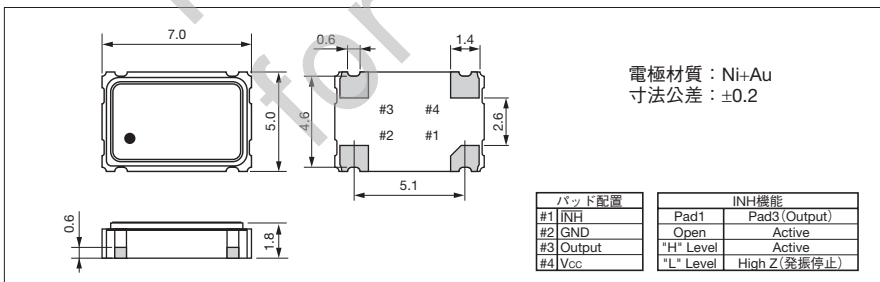
■規格

項目	記号	条件	規格		単位
			Min.	Max.	
出力周波数範囲*	f _o		80		MHz
周波数許容偏差 (Overall)	f _{tol}		-50	+50	×10 ⁻⁶
保存温度範囲	T _{stg}		-20	+85	°C
動作温度範囲	T _{use}		-10	+85	°C
最大定格電圧	—		-0.5	+6	V
電源電圧	V _{cc}	5.0V Typ.	+4.75	+5.25	V
消費電流 (最大負荷時)	I _{cc}		—	50	mA
スタンバイ時電流	I _{std}		—	40	μA
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{cc}	40	60	%
立上り/ 立下り時間	tr/ tf		—	5	ns
Lレベル出力電圧	V _{oL}		—	10% V _{cc}	V
Hレベル出力電圧	V _{oH}	@5.0V	90% V _{cc}	—	V
出力負荷条件 (CMOS)	L _{CMOS}	CMOS Output	—	15	pF
入力電圧範囲	V _{in}		V _{ss}	V _{cc}	V
Lレベル入力電圧	V _{iL}		—	0.8	V
Hレベル入力電圧	V _{iH}		2.2	—	V
ディセーブル時間	t _{dis}		—	100	ns
イネーブル時間	t _{ena}		—	100	μs
発振開始時間	t _{str}		—	10	ms

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。
* レンジ外の周波数については、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

